

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

JC978 U.S. PRO
10/073223
02/13/02


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 2月14日

II-2
D.G.
4-17-02

出願番号

Application Number:

特願2001-037271

出願人

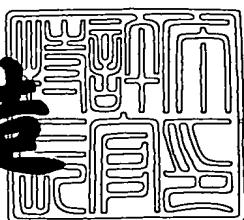
Applicant(s):

信越化学工業株式会社

2001年 8月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3076011

【書類名】 特許願
【整理番号】 13039
【提出日】 平成13年 2月14日
【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿
【国際特許分類】 G03F 07/00
【発明者】
【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
【氏名】 西 恒寛
【発明者】
【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
【氏名】 中島 瞳雄
【発明者】
【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
【氏名】 橘 誠一郎
【発明者】
【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島 28-1 信越化学工業株式会社 合成技術研究所内
【氏名】 船津 順之
【特許出願人】
【識別番号】 000002060
【氏名又は名称】 信越化学工業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100079304
【弁理士】
【氏名又は名称】 小島 隆司

【選任した代理人】

【識別番号】 100103595

【弁理士】

【氏名又は名称】 西川 裕子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

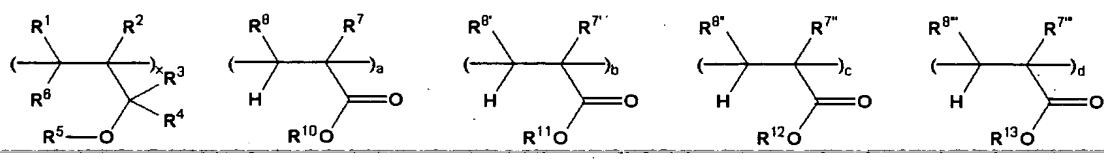
【書類名】 明細書

【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料、及びパターン形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

【化1】



(1)

(式中、R¹、R²は水素原子又はメチル基を示す。R³、R⁴は水素原子、水酸基又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の1価の炭化水素基を示す。R⁵は水素原子又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の1価の炭化水素基を示す。R⁶は水素原子又はメチル基を示す。R³とR⁴、R³又はR⁴とR⁵、R³又はR⁴とR⁶、R⁵とR⁶は結合して環を形成してもよく、その場合には各組み合わせで炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の2価の炭化水素基を示す。R⁷は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R⁹を示す。R^{7'}は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R⁹を示す。R^{7''}は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R⁹を示す。R^{7'''}は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R⁹を示す。R⁸は水素原子、メチル基又はCO₂R⁹を示す。R^{8'}は水素原子、メチル基又はCO₂R⁹を示す。R^{8''}は水素原子、メチル基又はCO₂R⁹を示す。R⁹、R^{9'}、R^{9''}、R^{9'''}はR⁷とR⁸、R^{7'}とR^{8'}、R^{7''}とR^{8''}、R^{7'''}とR^{8'''}で共通しても異なってもよい炭素数1~15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R¹⁰は水素原子又は炭素数1~15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の炭化水素基を示す。R¹¹は炭素数3~15のエーテル、エステル又はカルボン酸無水物構造を含有する1価の炭化水素基を示す。R¹²は炭素数7~15の多環式炭化水素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基を示す。R¹³は酸不安定

基を示す。x、a、b、c、dは各繰り返し単位のモル組成比を示し、xは0を超える数、a、b、cは0以上の数、dは0を超える数で、 $x + a + b + c + d = 1$ である。)

【請求項2】 上記一般式(1)において、R^{1 3}の酸不安定基が環状構造を有する3級アルキル基であることを特徴とする請求項1に記載の高分子化合物。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項4】 請求項3に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後フォトマスクを介して高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、(1)特定の構造を有する高分子化合物、(2)この高分子化合物をベース樹脂として含有するレジスト材料、及び(3)このレジスト材料を用いたパターン形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められているなか、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視されている。中でもKrFエキシマレーザー光、ArFエキシマレーザー光を光源としたフォトリソグラフィーは、0.3μm以下の超微細加工に不可欠な技術としてその実現が切望されている。

【0003】

KrFエキシマレーザー用レジスト材料では、実用可能レベルの透明性とエッチング耐性を併せ持つポリヒドロキシスチレンが事実上の標準ベース樹脂となっている。ArFエキシマレーザー用レジスト材料では、ポリアクリル酸又はポリ

メタクリル酸の誘導体や脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物等の材料が検討されているが、いずれのものについても長所と短所があり、未だ標準ベース樹脂が定まっていないのが現状である。

【0004】

即ち、ポリアクリル酸又はポリメタクリル酸の誘導体を用いたレジスト材料の場合、酸分解性基の反応性が高い、基板密着性に優れる等の利点が有り、感度と解像性については比較的良好な結果が得られるものの、樹脂の主鎖が軟弱なためにエッティング耐性が極めて低く、実用的でない。一方、脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物を用いたレジスト材料の場合、樹脂の主鎖が十分剛直なためにエッティング耐性は実用レベルにあるものの、酸分解性保護基の反応性が（メタ）アクリル系のものに比べて大きく劣るために低感度及び低解像性であり、また樹脂の主鎖が剛直過ぎるために基板密着性が低く、やはり好適でない。

【0005】

また、（メタ）アクリル系、脂環主鎖系の双方に共通の問題として、レジスト膜の膨潤によるパターンの崩壊がある。これらの系のレジスト材料は、露光前後の溶解速度差を大きくすることでその解像性能を向上させてきており、その結果、非常に疎水性の高いものとなってしまっている。高疎水性のレジスト材料は、未露光部では強力に膜を維持し、過露光部では瞬時に膜を溶解させることができる一方で、その間のかなり広い露光領域では現像液の浸入を許しながらも溶解には至らず、即ち膨潤する。実際にArFエキシマレーザーが用いられる極めて微細なパターンサイズでは、膨潤によって隣接するパターンが癒着、崩壊してしまうレジスト材料は使用できない。パターンルールのより一層の微細化が求められる中、感度、解像性、エッティング耐性において優れた性能を発揮することに加え、更に膨潤も十分に抑えられたレジスト材料が必要とされているのである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記事情に鑑みなされたもので、（1）反応性、剛直性及び基板密着性に優れ、かつ現像時の膨潤の小さい高分子化合物、（2）該高分子化合物をベース樹脂とし、従来品を大きく上回る解像性及びエッティング耐性を有するレジス

ト材料、及び(3)該レジスト材料を用いたパターン形成方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、後述する方法によって得られる下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の新規高分子化合物が反応性、剛直性及び基板密着性に優れ、また現像液に対する溶解性が適度に高く、膨潤が小さいこと、この高分子化合物をベース樹脂として用いたレジスト材料が高解像性及び高エッチング耐性を有すること、そしてこのレジスト材料が精密な微細加工に極めて有効であることを知見した。

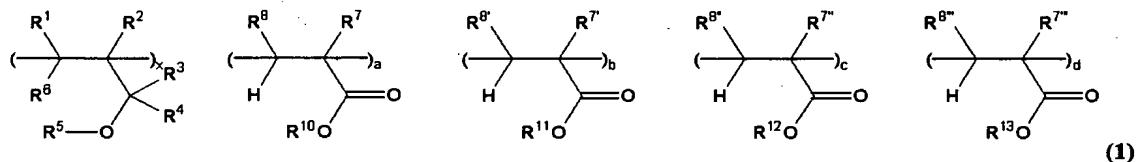
【0008】

即ち、本発明は下記の高分子化合物を提供する。

[I] 下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

【0009】

【化2】



(式中、R¹、R²は水素原子又はメチル基を示す。R³、R⁴は水素原子、水酸基又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の1価の炭化水素基を示す。R⁵は水素原子又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の1価の炭化水素基を示す。R⁶は水素原子又はメチル基を示す。R³とR⁴、R³又はR⁴とR⁵、R³又はR⁴とR⁶、R⁵とR⁶は結合して環を形成してもよく、その場合には各組み合わせで炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の2価の炭化水素基を示す。R⁷は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R⁹を示す。R^{7'}は水素原子、メチル基又はCH₂CO₂R^{9'}を示す。R^{7''}は水素原子、メチル

[0 0 1 0]

[II] 上記一般式(1)において、 $R^{1,3}$ の酸不安定基が環状構造を有する3級アルキル基であることを特徴とする[I]に記載の高分子化合物。

[0 0 1 1]

また、本発明は下記のレジスト材料を提供する。

〔I I I〕 〔I〕 又は 〔I I〕 に記載の高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

[0 0 1 2]

更に、本発明は下記のパターン形成方法を提供する。

[IV] [III] に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、加熱処理後フォトマスクを介して高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

[0 0 1 3]

上記一般式（1）で示される高分子化合物は、アリルエーテル化合物と（メタ

) アクリル酸誘導体の共重合体である。前述の通り、(メタ)アクリル酸系の高分子化合物は感度と解像性に優れるもののエッティング耐性に劣るが、その原因の一端はエステル結合の多さ、炭素密度の低さにある。本発明の高分子化合物では、共重合単位の一部をアリルエーテル化合物とすることで、(メタ)アクリル酸系の高分子化合物の利点である感度と解像性を損なわずに、エッティング耐性を改善している。それでいて、主鎖に脂環を導入した場合に見られる、現像液のはじきや現像時の膨潤・パターン崩壊といった好ましくない現象とは無縁である。従って、この高分子化合物をベース樹脂としたレジスト材料は、感度、解像性及びエッティング耐性の全てにおいて優れた性能を有し、更に現像時の膨潤も十分に抑制されており、微細パターンの形成に極めて有用なものとなるのである。

【0014】

なお、本発明のアリルエーテル化合物を構成単位として含有する高分子化合物と類似のものとして、ビニルエーテル化合物を含有するビニルエーテル-無水マレイン酸交互重合体、及びこれにアクリル酸誘導体単位を共重合させた混成重合体が知られており、レジスト材料のベース樹脂としての使用も提案されているが、いずれも必須の単位として無水マレイン酸を含有するものである。しかしながら、無水マレイン酸は酸素含有率が高くてエッティング耐性に悪影響を及ぼすだけでなく、保存時に系内の水分と反応して開環し、レジスト材料の性能を著しく劣化させるという欠点を有する。本発明の高分子化合物は、無水マレイン酸を含むことなくアリルエーテル化合物を(メタ)アクリル酸系の高分子化合物に導入したもので、感度、解像性、エッティング耐性に優れるだけでなく、秀逸な保存安定性をも有するものとなったのである。

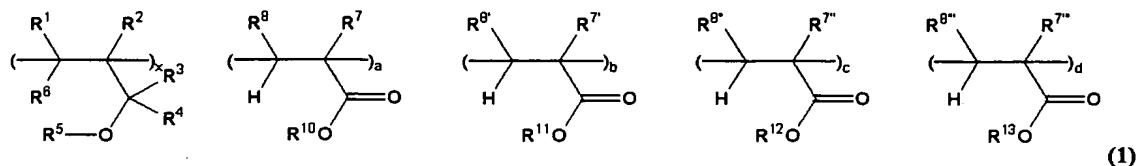
【0015】

以下、本発明につき更に詳細に説明する。

本発明の新規高分子化合物は、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物である。

【0016】

【化3】



【0017】

ここで、 R^1 、 R^2 は水素原子又はメチル基を示す。 R^3 、 R^4 は水素原子、水酸基又は炭素数 1 ~ 15 のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の 1 値の炭化水素基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、tert-アミル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、エチルシクロペンチル基、ブチルシクロペンチル基、エチルシクロヘキシル基、ブチルシクロヘキシル基、アダマンチル基、エチルアダマンチル基、ブチルアダマンチル基等のアルキル基、及びこれらの基に含まれる水素原子の一部がヘテロ原子団に置換されていたり、隣接する炭素原子の間にヘテロ原子団が挿入されていたりして、アルコール、エーテル、アルデヒド、ケトン、カルボン酸、エステル、カルボン酸無水物、アミド、スルホン酸、スルホン酸エステル、スルホンアミド等の部分構造を有する基を例示できる。より具体的には、ヘテロ原子を含む 1 値炭化水素基としては、上記アルキル基の水素原子の一部が OH 基、 NH_2 基、 COOH 基、フッ素原子等で置換したもの、水素原子の 2 個のカルボニル基の酸素原子に置換されたもの、上記アルキル基の炭素-炭素間に $-\text{O}-$ 、 $-\text{NH}-$ 、 $-\text{N}(\text{CH}_3)-$ 、 $-\text{SO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{COO}-$ などが介在したものなどが挙げられる。 R^5 は水素原子又は炭素数 1 ~ 15 のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の 1 値の炭化水素基を示し、具体的には R^3 、 R^4 の具体例と同様のものを例示できる。 R^6 は水素原子又はメチル基を示す。 R^3 と R^4 、 R^3 又は R^4 と R^5 、 R^3 又は R^4 と R^6 、 R^5 と R^6 は結合して環を形成してもよく、その場合には各組み合わせで炭素数 1 ~ 15 のヘテロ原子を含んでもよい直鎖状、分岐状又は環状の 2 値の炭化水素基を示し、具体的には上記ヘテロ原子を含んでもよい 1 値の炭化水素基として例示した基の任意の位置の水素原子を除いてできる 2 値の基を例示できる。

【0018】

R^7 は水素原子、メチル基又は $CH_2CO_2R^9$ を示す。 $R^{7'}$ は水素原子、メチル基又は $CH_2CO_2R^{9'}$ を示す。 $R^{7''}$ は水素原子、メチル基又は $CH_2CO_2R^{9''}$ を示す。 $R^{7'''}$ は水素原子、メチル基又は $CH_2CO_2R^{9'''}$ を示す。 R^8 は水素原子、メチル基又は CO_2R^9 を示す。 $R^{8'}$ は水素原子、メチル基又は $CO_2R^{9'}$ を示す。 $R^{8''}$ は水素原子、メチル基又は $CO_2R^{9''}$ を示す。 R^9 、 $R^{9'}$ 、 $R^{9''}$ 、 $R^{9'''}$ は R^7 と R^8 、 $R^{7'}$ と $R^{8'}$ 、 $R^{7''}$ と $R^{8''}$ 、 $R^{7'''}$ と $R^{8'''}$ で共通しても異なってもよい炭素数1～15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、tert-アミル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、エチルシクロペンチル基、ブチルシクロペンチル基、エチルシクロヘキシル基、ブチルシクロヘキシル基、アダマンチル基、エチルアダマンチル基、ブチルアダマンチル基等を例示できる。

【0019】

R^{10} は水素原子又は炭素数1～15のカルボキシ基又は水酸基を含有する1価の炭化水素基を示し、具体的には水素原子、カルボキシエチル、カルボキシブチル、カルボキシシクロペンチル、カルボキシシクロヘキシル、カルボキシノルボルニル、カルボキシアダマンチル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシブチル、ヒドロキシシクロペンチル、ヒドロキシシクロヘキシル、ヒドロキシノルボルニル、ヒドロキシアダマンチル等が例示できる。 R^{11} は炭素数3～15のエーテル、エステル又はカルボン酸無水物構造を含有する1価の炭化水素基を示し、具体的には7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イルメチル、2-オキソオキソラン-3-イル、2-オキソオキソラン-4-イル、4,4-ジメチル-2-オキソオキソラン-3-イル、4-メチル-2-オキソオキサン-4-イル、2-オキソ-1,3-ジオキソラン-4-イルメチル、5-メチル-2-オキソオキソラン-5-イル等を例示できる。 R^{12} は炭素数7～15の多環式炭化水素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基を示し、具体的にはノルボ

ルニル、ビシクロ[3.3.1]ノニル、トリシクロ[5.2.1.0^{2,6}]デシル、アダマンチル、エチルアダマンチル、ブチルアダマンチル、ノルボルニルメチル、アダマンチルメチル等を例示できる。R¹³は酸不安定基を示す。x、a、b、c、dは各繰り返し単位のモル組成比を示し、xは0を超える数、a、b、cは0以上の数、dは0を超える数で、x+a+b+c+d=1であり、x、a、b、c、dの好ましい範囲は以下の通りである。

【0020】

x：好ましくは0.05以上0.7以下、より好ましくは0.1以上0.6以下

a：好ましくは0以上0.4以下、より好ましくは0以上0.3以下

b：好ましくは0以上0.5以下、より好ましくは0以上0.4以下

c：好ましくは0以上0.4以下、より好ましくは0以上0.3以下

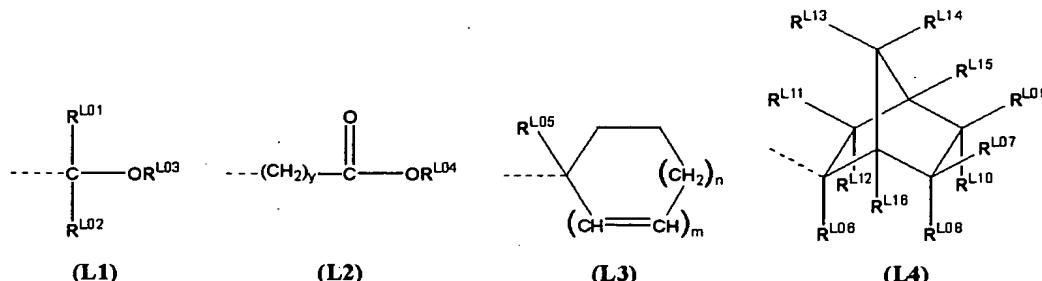
d：好ましくは0.1以上0.8以下、より好ましくは0.2以上0.7以下

【0021】

R¹³の酸不安定基としては、種々用いることができるが、具体的には下記一般式(L1)～(L4)で示される基、炭素数4～20、好ましくは4～15の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1～6のトリアルキルシリル基、炭素数4～20のオキソアルキル基等を挙げることができる。

【0022】

【化4】



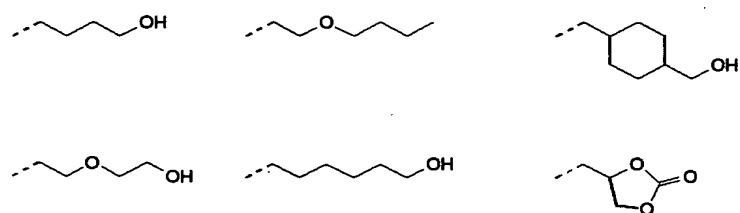
【0023】

ここで、鎖線は結合手を示す（以下、同様）。式中、R^{L01}、R^{L02}は水素原子又は炭素数1～18、好ましくは1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基

、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルヘキシル基、n-オクチル基等が例示できる。R^{L03}は炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基等に置換されたものを挙げることができ、具体的には下記の置換アルキル基等が例示できる。

【0024】

【化5】



【0025】

R^{L01}とR^{L02}、R^{L01}とR^{L03}、R^{L02}とR^{L03}とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR^{L01}、R^{L02}、R^{L03}はそれぞれ炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。

【0026】

R^{L04}は炭素数4~20、好ましくは4~15の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基又は上記一般式(L1)で示される基を示し、三級アルキル基としては、具体的にはtert-ブチル基、tert-アミル基、1,1-ジエチルプロピル基、2-シクロペンチルプロパン-2-イル基、2-シクロヘキシルプロパン-2-イル基、2-(ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)プロパン-2-イル基、2-(アダマンタン-1-イル)プロパン-2-イル基、1-エチルシクロペンチル基、1-ブチルシクロペンチル基、1-エチルシクロヘキシル基、1-ブチルシクロヘキシル基、1-エチル-2-シクロペンテニル基、1-エチル-2-シクロヘキセニル基、2-メチル-2-アダマンチル基、2-エチル-2-アダマンチル基等が例示でき、トリアルキルシリル基としては、具

体的にはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチル-*t e r t*-ブチルシリル基等が例示でき、オキソアルキル基としては、具体的には3-オキソシクロヘキシル基、4-メチル-2-オキソオキサン-4-イル基、5-メチル-2-オキソオキソラン-5-イル基等が例示できる。yは0~6の整数である。

【0027】

R^{L05} は炭素数1~8のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基又は炭素数6~20の置換されていてもよいアリール基を示し、ヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基としては、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s e c*-ブチル基、*t e r t*-ブチル基、*t e r t*-アミル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、オキソ基、アミノ基、アルキルアミノ基、シアノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、スルホ基等に置換されたもの等が例示でき、置換されていてもよいアリール基としては、具体的にはフェニル基、メチルフェニル基、ナフチル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基等が例示できる。mは0又は1、nは0、1、2、3のいずれかであり、 $2m+n=2$ 又は3を満足する数である。

【0028】

R^{L06} は炭素数1~8のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基又は炭素数6~20の置換されていてもよいアリール基を示し、具体的には R^{L05} と同様のもの等が例示できる。 $R^{L07} \sim R^{L16}$ はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数1~15のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基を示し、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、*s e c*-ブチル基、*t e r t*-ブチル基、*t e r t*-アミル基、*n*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、*n*-オクチル基、*n*-ノニル基、*n*-デシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチルメチル基、シクロペンチルエチル基、シクロペンチルブチル基、シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシルエチル基、シクロヘキシルブチル基等の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が水酸基、アルコキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、オキ

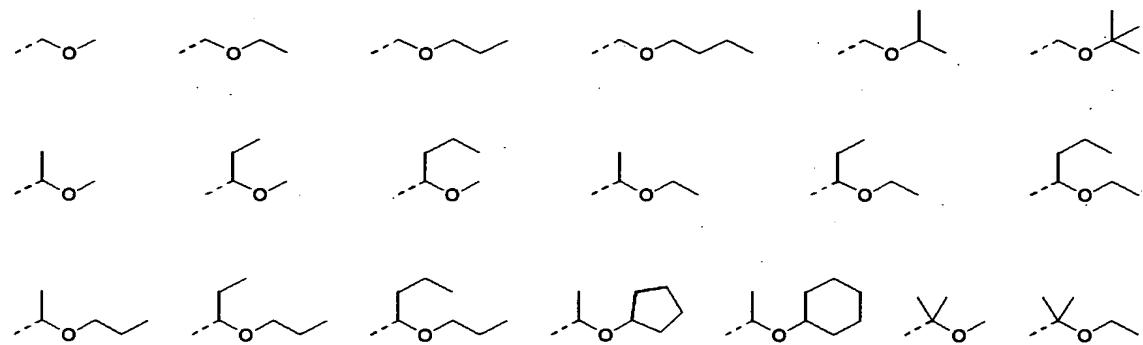
ソ基、アミノ基、アルキルアミノ基、シアノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、スルホ基等に置換されたもの等が例示できる。R^{L07}～R^{L16}は互いに環を形成していてもよく（例えば、R^{L07}とR^{L08}、R^{L07}とR^{L09}、R^{L08}とR^{L10}、R^{L09}とR^{L10}、R^{L11}とR^{L12}、R^{L13}とR^{L14}等）、その場合には炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい2価の炭化水素基を示し、具体的には上記1価の炭化水素基で例示したものから水素原子を1個除いたもの等が例示できる。また、R^{L07}～R^{L16}は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介さずに結合し、二重結合を形成してもよい（例えば、R^{L07}とR^{L09}、R^{L09}とR^{L15}、R^{L13}とR^{L15}等）。

【0029】

上記式（L1）で示される酸不安定基のうち直鎖状又は分岐状のものとしては、具体的には下記の基が例示できる。

【0030】

【化6】



【0031】

上記式（L1）で示される酸不安定基のうち環状のものとしては、具体的にはテトラヒドロフラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2-イル基、2-メチルテトラヒドロピラン-2-イル基等が例示できる。

【0032】

上記式（L2）の酸不安定基としては、具体的にはtert-ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニルメチル基、tert-アミロキシカルボニル基、tert-アミロキシカルボニルメチル基、1,1-ジエチルプロピル

オキシカルボニル基、1,1-ジエチルプロピルオキシカルボニルメチル基、1-エチルシクロペンチルオキシカルボニル基、1-エチルシクロペンチルオキシカルボニルメチル基、1-エチル-2-シクロペンテニルオキシカルボニル基、1-エチル-2-シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1-エトキシカルボニルメチル基、2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2-テトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。

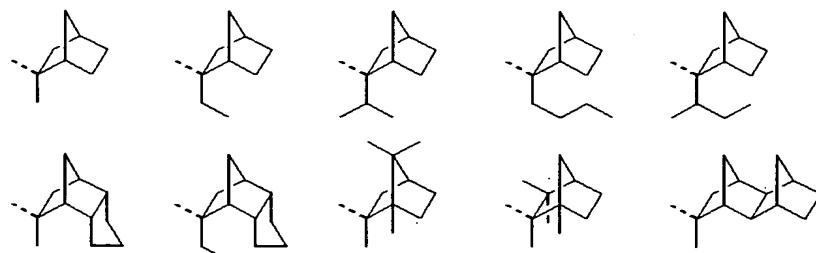
【0033】

上記式(L3)の酸不安定基としては、具体的には1-メチルシクロペンチル、1-エチルシクロペンチル、1-n-プロピルシクロペンチル、1-イソプロピルシクロペンチル、1-n-ブチルシクロペンチル、1-sec-ブチルシクロペンチル、1-メチルシクロヘキシル、1-エチルシクロヘキシル、3-メチル-1-シクロペンテン-3-イル、3-エチル-1-シクロペンテン-3-イル、3-メチル-1-シクロヘキセン-3-イル、3-エチル-1-シクロヘキセン-3-イル等が例示できる。

【0034】

上記式(L4)の酸不安定基としては、具体的には下記の基が例示できる。

【化7】



【0035】

また、炭素数4～20の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1～6のトリアルキルシリル基、炭素数4～20のオキソアルキル基としては、具体的には R^{L04} で挙げたものと同様のもの等が例示できる。

【0036】

R^{13} の酸不安定基として例示した上記の基の中でも、特に好ましいのは環状構造を有する3級アルキル基である。3級アルキル基は酸性条件下での脱離反応

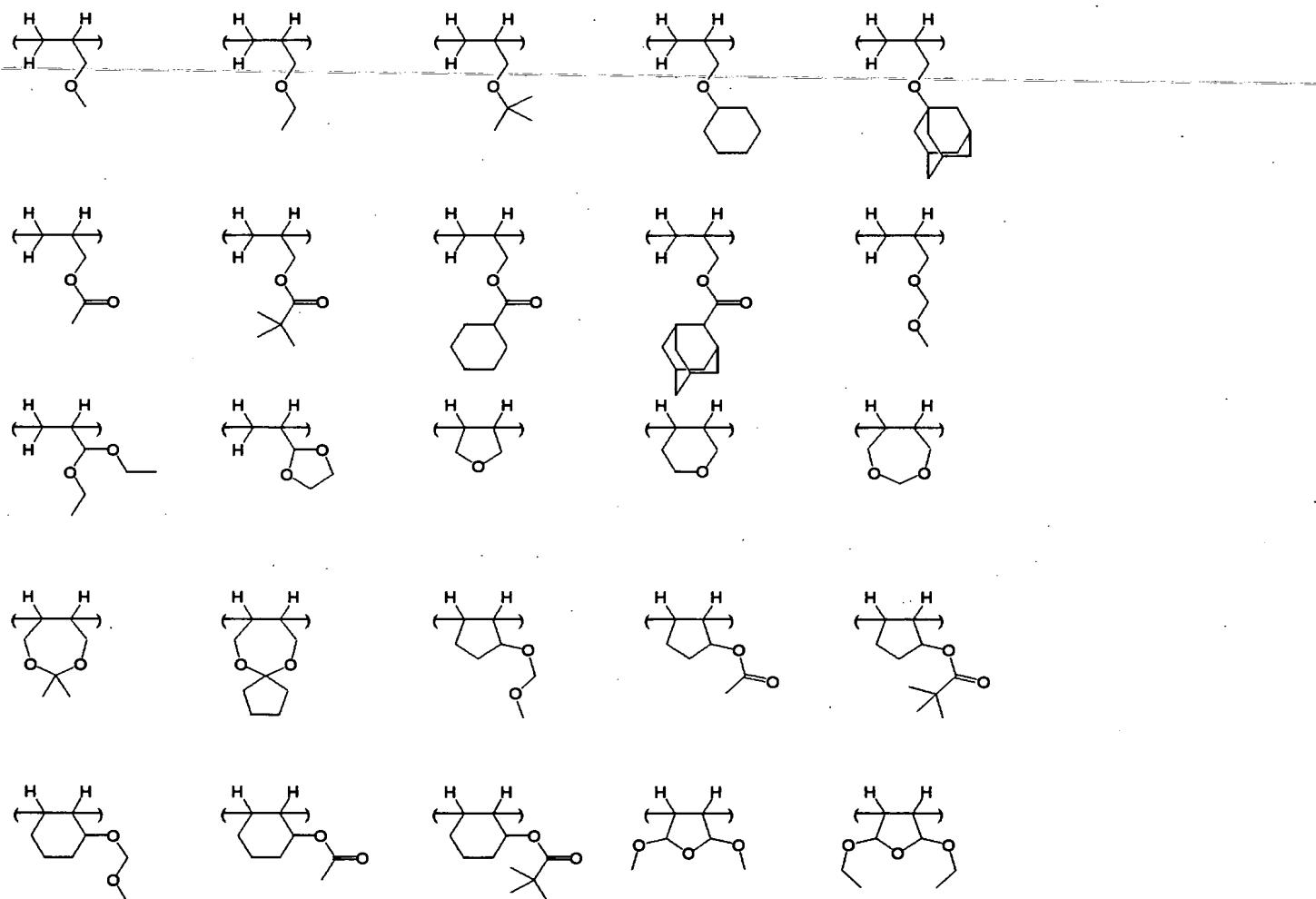
性が高すぎないために保存安定性に優れ、また環状構造を有することで高分子化合物の剛直性が高まってエッティング耐性が向上するからである。

【0037】

上記一般式（1）で示される高分子化合物のうち、モル組成比 x で導入される単位の具体例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0038】

【化8】

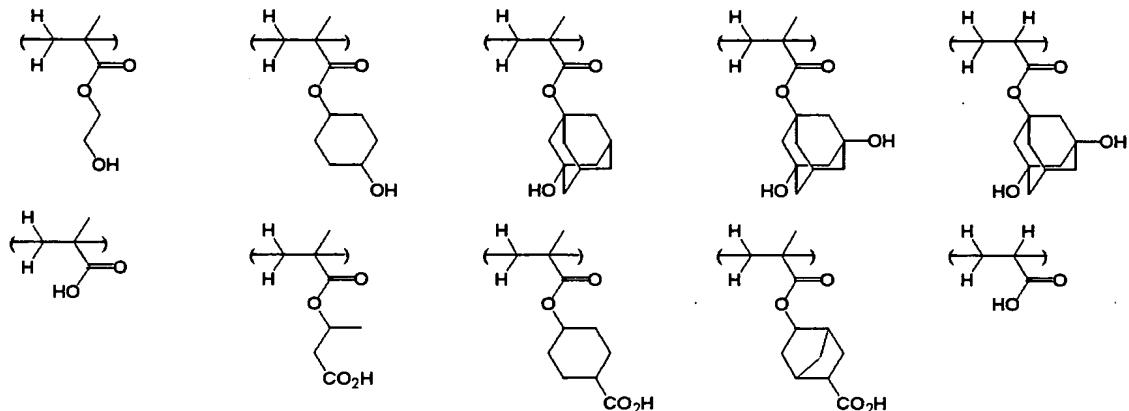


【0039】

上記一般式（1）で示される高分子化合物のうち、モル組成比 a で導入される単位の具体例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0040】

【化9】

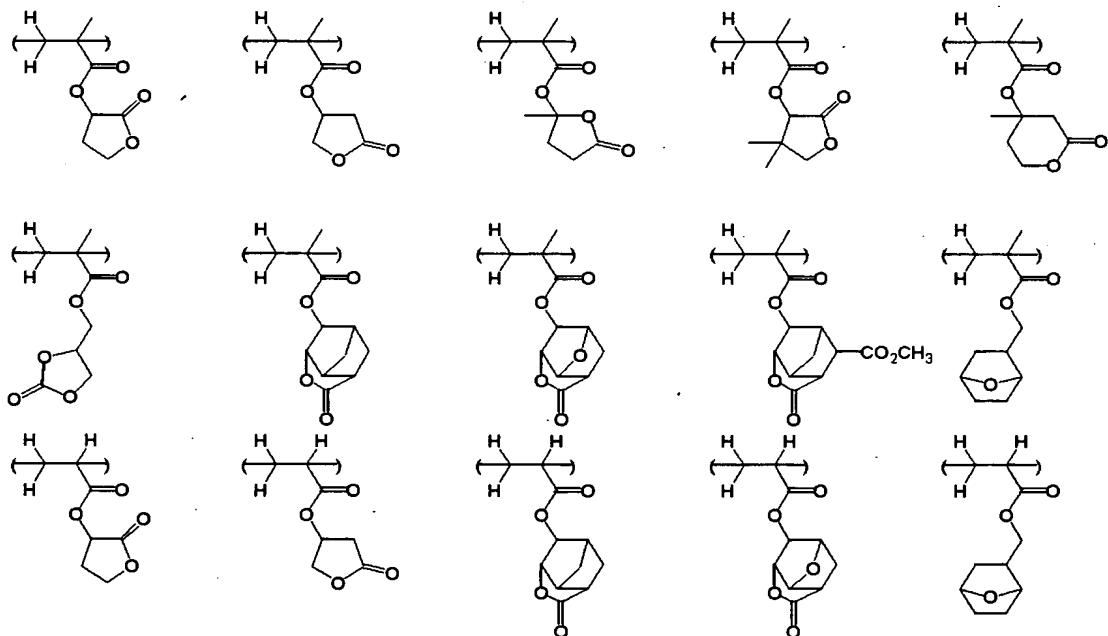


【0041】

上記一般式（1）で示される高分子化合物のうち、モル組成比bで導入される単位の具体例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0042】

【化10】

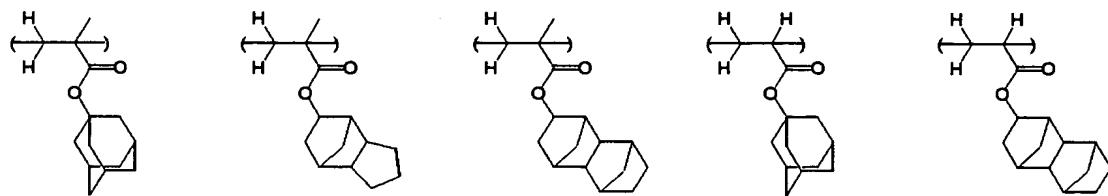


【0043】

上記一般式（1）で示される高分子化合物のうち、モル組成比cで導入される単位の具体例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0044】

【化11】

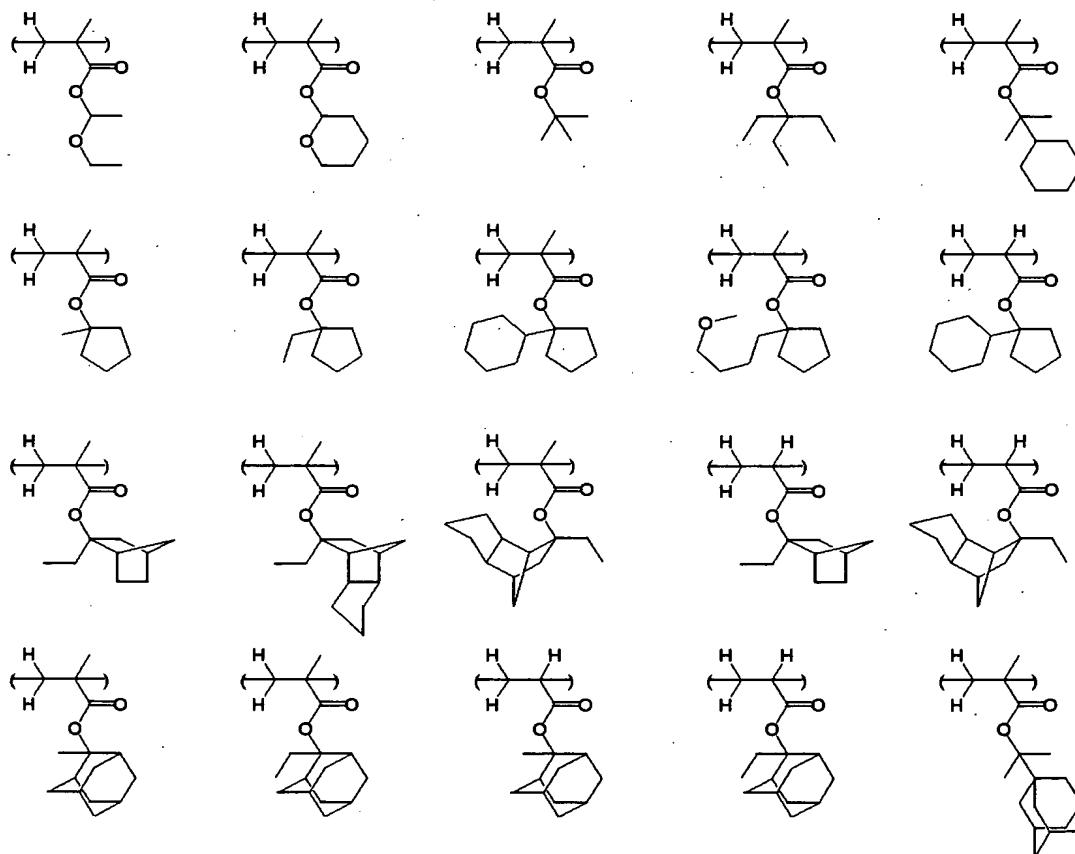


【0045】

上記一般式（1）で示される高分子化合物のうち、モル組成比dで導入される単位の具体例を以下に示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0046】

【化12】



【0047】

上記の各繰り返し単位は、レジスト材料とした際の溶解コントラスト、現像液親和性、基板密着性、エッチング耐性等の諸特性を付与するものであり、これらの繰り返し単位の含有量を適宜調整することにより、レジスト材料の性能を微調

整することができる。

【0048】

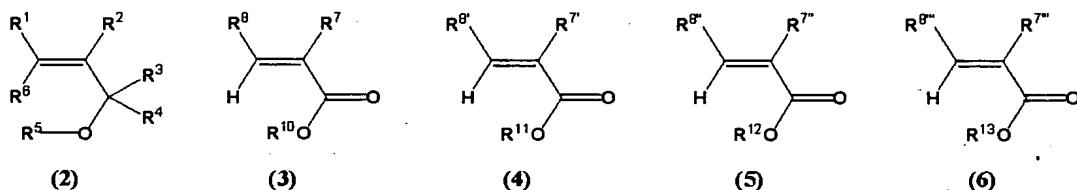
なお、本発明の高分子化合物の重量平均分子量はポリスチレン換算でのゲルパーキューションクロマトグラフィー（G P C）を用いて測定した場合、1,000～500,000、好ましくは3,000～100,000である。この範囲を外れると、エッティング耐性が極端に低下したり、露光前後の溶解速度差が確保できなくなって解像性が低下したりすることがある。

【0049】

本発明の高分子化合物の製造は、下記一般式（2）で示される化合物を第1の单量体に、下記一般式（6）で示される化合物を第2の单量体に、必要に応じ、下記一般式（3）～（5）で示される化合物から選ばれる1～3種を第3～5の单量体に用いた共重合反応により行うことができる。

【0050】

【化13】



（式中、R¹～R¹³、R^{7'}、R^{7''}、R^{7'''}、R^{8'}、R^{8''}、R^{8'''}、x、a、b、c、dは上記と同様である。）

【0051】

共重合反応においては、各单量体の存在割合を適宜調節することにより、レジスト材料とした時に好ましい性能を発揮できるような高分子化合物とすることができる。

【0052】

この場合、本発明の高分子化合物は、

- (i) 上記式（2）の单量体
- (i i) 上記式（6）の单量体
- (i i i) 上記式（3）～（5）の单量体

に加え、更に、

(i v) 上記 (i) ~ (i i i) 以外の炭素-炭素二重結合を含有する単量体、例えば、メタクリル酸メチル、クロトン酸メチル、マレイン酸ジメチル、イタコン酸ジメチル等の置換アクリル酸エステル類、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸、無水イタコン酸等の不飽和酸無水物、その他の単量体を共重合しても差支えない。

【0053】

本発明の高分子化合物を製造する共重合反応は種々例示することができるが、好ましくはラジカル重合である。

【0054】

ラジカル重合反応の反応条件は、(ア) 溶剤としてベンゼン等の炭化水素類、テトラヒドロフラン等のエーテル類、エタノール等のアルコール類、又はメチルイソブチルケトン等のケトン類を用い、(イ) 重合開始剤として2, 2' -アソビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物、又は過酸化ベンゾイル、過酸化ラウロイル等の過酸化物を用い、(ウ) 反応温度を0℃から100℃程度に保ち、(エ) 反応時間を0.5時間から48時間程度とするのが好ましいが、この範囲を外れる場合を排除するものではない。

【0055】

本発明の高分子化合物は、レジスト材料のベースポリマーとして有効であり、本発明は、この高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料、特に化学増幅ポジ型レジスト材料を提供する。

【0056】

本発明のレジスト材料には、高エネルギー線もしくは電子線に感応して酸を発生する化合物（以下、酸発生剤）、有機溶剤、必要に応じてその他の成分を含有することができる。

【0057】

本発明で使用される酸発生剤としては、

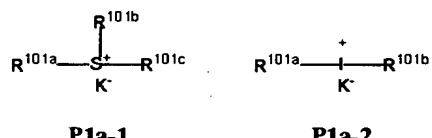
- i. 下記一般式 (P 1 a - 1)、(P 1 a - 2) 又は (P 1 b) のオニウム塩、
- i i. 下記一般式 (P 2) のジアゾメタン誘導体、

i i i. 下記一般式 (P 3) のグリオキシム誘導体、
 i v. 下記一般式 (P 4) のビススルホン誘導体、
 v. 下記一般式 (P 5) のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル、
 v i. β -ケトスルホン酸誘導体、
 v i i. ジスルホン誘導体、
 v i i i. ニトロベンジルスルホネート誘導体、
 i x. スルホン酸エステル誘導体

等が挙げられる。

【0058】

【化14】



(式中、R^{101a}、R^{101b}、R^{101c}はそれぞれ炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、アルケニル基、オキソアルキル基又はオキソアルケニル基、炭素数6～20のアリール基、又は炭素数7～12のアラルキル基又はアリールオキソアルキル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部がアルコキシ基等によって置換されていてもよい。また、R^{101b}とR^{101c}とは環を形成してもよく、環を形成する場合には、R^{101b}、R^{101c}はそれぞれ炭素数1～6のアルキレン基を示す。K⁻は非求核性対向イオンを表す。)

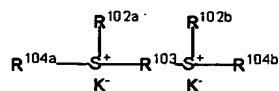
【0059】

上記R^{101a}、R^{101b}、R^{101c}は互いに同一であっても異なっていてもよく、具体的にはアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘ

キセニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、2-オキソシクロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基等が挙げられ、2-オキソプロピル基、2-シクロペンチル-2-オキソエチル基、2-シクロヘキシル-2-オキソエチル基、2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-オキソエチル基等を挙げることができる。アリール基としては、フェニル基、ナフチル基等や、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基、メチルナフチル基、エチルナフチル基等のアルキルナフチル基、メトキシナフチル基、エトキシナフチル基等のアルコキシナフチル基、ジメチルナフチル基、ジエチルナフチル基等のジアルキルナフチル基、ジメトキシナフチル基、ジエトキシナフチル基等のジアルコキシナフチル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェニルエチル基、フェネチル基等が挙げられる。アリールオキソアルキル基としては、2-フェニル-2-オキソエチル基、2-(1-ナフチル)-2-オキソエチル基、2-(2-ナフチル)-2-オキソエチル基等の2-アリール-2-オキソエチル基等が挙げられる。K⁻の非求核性対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、1,1,1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられる。

【0060】

【化15】



P1b

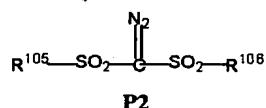
(式中、 R^{102a} 、 R^{102b} はそれぞれ炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 R^{103} は炭素数1～10の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示す。 R^{104a} 、 R^{104b} はそれぞれ炭素数3～7の2-オキソアルキル基を示す。 K^- は非求核性対向イオンを表す。)

【0061】

上記 R^{102a} 、 R^{102b} として具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロプロピルメチル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘキシルメチル基等が挙げられる。 R^{103} としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、1,2-シクロヘキシレン基、1,3-シクロペンチレン基、1,4-シクロオクチレン基、1,4-シクロヘキサンジメチレン基等が挙げられる。 R^{104a} 、 R^{104b} としては、2-オキソプロピル基、2-オキソシクロペンチル基、2-オキソシクロヘキシル基、2-オキソシクロヘプチル基等が挙げられる。 K^- は式(P1a-1)及び(P1a-2)で説明したものと同様のものを挙げることができる。

【0062】

【化16】



(式中、 R^{105} 、 R^{106} は炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数6～20のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数7～12のアラルキル基を示す。)

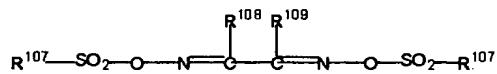
【0063】

R^{105} 、 R^{106} のアルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙

げられる。ハロゲン化アルキル基としてはトリフルオロメチル基、1, 1, 1-トリフルオロエチル基、1, 1, 1-トリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフェニル基、p-メトキシフェニル基、m-メトキシフェニル基、o-メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化アリール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル基、1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

【0064】

【化17】



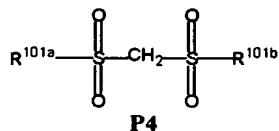
(式中、 R^{107} 、 R^{108} 、 R^{109} は炭素数1～12の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数6～20のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数7～12のアラルキル基を示す。 R^{108} 、 R^{109} は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、 R^{108} 、 R^{109} はそれぞれ炭素数1～6の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

【0065】

R^{107} 、 R^{108} 、 R^{109} のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、 R^{105} 、 R^{106} で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、 R^{108} 、 R^{109} のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0066】

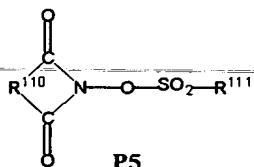
【化18】



(式中、R^{101a}、R^{101b}は上記と同じである。)

【0067】

【化19】



(式中、R¹¹⁰は炭素数6～10のアリーレン基、炭素数1～6のアルキレン基又は炭素数2～6のアルケニレン基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1～4の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルコキシ基、ニトロ基、アセチル基、又はフェニル基で置換されていてもよい。R¹¹¹は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は置換のアルキル基、アルケニル基又はアルコキシアルキル基、フェニル基、又はナフチル基を示し、これらの基の水素原子の一部又は全部は更に炭素数1～4のアルキル基又はアルコキシ基；炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基；炭素数3～5のヘテロ芳香族基；又は塩素原子、フッ素原子で置換されていてもよい。)

【0068】

ここで、R¹¹⁰のアリーレン基としては、1, 2-フェニレン基、1, 8-ナフチレン基等が、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、フェニルエチレン基、ノルボルナン-2, 3-ジイル基等が、アルケニレン基としては、1, 2-ビニレン基、1-フェニル-1, 2-ビニレン基、5-ノルボルネン-2, 3-ジイル基等が挙げられる。R¹¹¹のアルキル基としては、R^{101a}～R^{101c}と同様のものが、アルケニル基としては、ビニル基、1-プロペニル基、アリル基、1-ブテニル基、3-ブテニル基、イソブレニル基、1-ペンテニル基、3-ペンテニル基、4-ペンテ

ニル基、ジメチルアリル基、1-ヘキセニル基、3-ヘキセニル基、5-ヘキセニル基、1-ヘプテニル基、3-ヘプテニル基、6-ヘプテニル基、7-オクテニル基等が、アルコキシアルキル基としては、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、ブトキシメチル基、ペンチロキシメチル基、ヘキシロキシメチル基、ヘプチロキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、プロポキシエチル基、ブトキシエチル基、ペンチロキシエチル基、ヘキシロキシエチル基、メトキシプロピル基、エトキシプロピル基、プロポキシプロピル基、ブトキシプロピル基、メトキシブチル基、エトキシブチル基、プロポキシブチル基、メトキシペンチル基、エトキシペンチル基、メトキシヘキシル基、メトキシヘプチル基等が挙げられる。

【0069】

なお、更に置換されていてもよい炭素数1～4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基等が、炭素数1～4のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブトキシ基等が、炭素数1～4のアルキル基、アルコキシ基、ニトロ基又はアセチル基で置換されていてもよいフェニル基としては、フェニル基、トリル基、p-tert-ブトキシフェニル基、p-アセチルフェニル基、p-ニトロフェニル基等が、炭素数3～5のヘテロ芳香族基としては、ピリジル基、フリル基等が挙げられる。

【0070】

具体的には、例えばトリフルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)

スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタノスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニル)メチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、エチレンビス[メチル(2-オキソシクロペンチル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホナート]、1, 2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(キシレンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロペンチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-アミルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソアミルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-アミルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-アミルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニル-1-(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、1-シクロヘキシルスルホニ

ル-1- (tert-アミルスルホニル) ジアゾメタン、1-tert-アミルスルホニル-1- (tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) - α -ジフェニルグリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (p-トルエンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジフェニルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) - α -ジシクロヘキシルグリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O- (メタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (トリフルオロメタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (1, 1, 1-トリフルオロエタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (tert-ブタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (パフルオロオクタンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (シクロヘキサンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (ベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-フルオロベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (p-tert-ブチルベンゼンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (キレンスルホニル) - α -ジメチルグリオキシム、ビス-O- (カンファースルホニル) - α -ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン、ビストリフルオロメチルスルホニルメタン、ビスマチルスルホニルメタン、ビスエチルスルホニルメタン、ビスプロピルスルホニルメタン、ビスイソプロピルスルホニルメタン、ビス-p-トルエンスルホニルメタン、ビスベニゼンスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、2-シクロヘキシルカルボニル-2- (p-トルエンスルホニル) プロパン、2-イソプロピルカルボニル-2- (p-トルエンスルホニル) プロパン等の β -ケトスルホン誘導体、ジフェ

ニルジスルホン、ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンスルホン酸2, 6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホン酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1, 2, 3-トリス(メタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1, 2, 3-トリス(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1, 2, 3-トリス(p-トルエンスルホニルオキシ)ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、N-ヒドロキシスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ペンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-オクタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-トルエンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-メトキシベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-クロロエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ナフタレンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-2-フェニルスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシマレイミドエタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-2-フェニルマレイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシグルタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキ

シイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2、3-ジカルボキシイミドp-トルエンスルホン酸エステル等のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン酸エステル誘導体等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニル)メチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、1、2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ビス-O-(p-トルエンスルホニル)- α -ジメチルグリオキシム、ビス-O-(n-ブタンスルホニル)- α -ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導体、ビスナフチルスルホニルメタン等のビススルホン誘導体、N-ヒドロキシスクシンイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド2-プロパンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミド1-ペンタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシスクシンイミドp-トルエンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドメタンスルホン酸エステル、N-ヒドロキシナフタルイミドベンゼンスルホン酸エステル等のN-ヒドロキシイミド化合物のスルホン

酸エステル誘導体が好ましく用いられる。なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減効果に優れるため、両者を組み合わせることによりプロファイルの微調整を行うことが可能である。

【0071】

酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部（重量部、以下同様）に対して好ましくは0.1～1.5部、より好ましくは0.5～8部である。0.1部より少ないと感度が悪い場合があり、1.5部より多いと透明性が低くなり解像性が低下する場合がある。なお、ベース樹脂100部は、上記式（1）の繰り返し単位を有する高分子化合物と、後述する式（R1）、（R2）の繰り返し単位を有する高分子化合物の総量100部を意味する（以下、同様）。

【0072】

本発明で使用される有機溶剤としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添加剤等が溶解可能な有機溶剤であればいずれでもよい。このような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサン、メチル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert-ブチル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレングリコールモノtert-ブチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種以上を混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチル

エーテルや1-エトキシ-2-プロパノールの他、安全溶剤であるプロピレン
リコールモノメチルエーテルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される

【0073】

有機溶剤の使用量は、ベース樹脂100部に対して200~1,000部、特に
400~800部が好適である。

【0074】

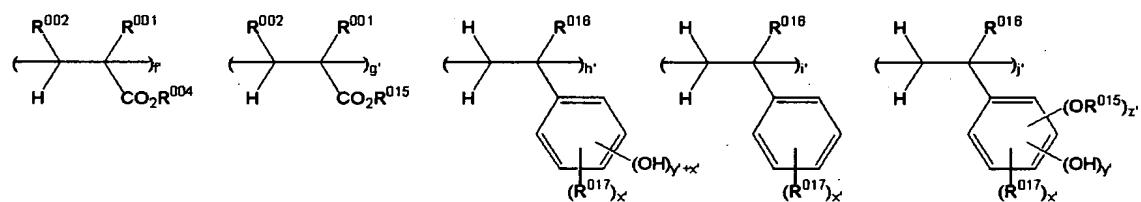
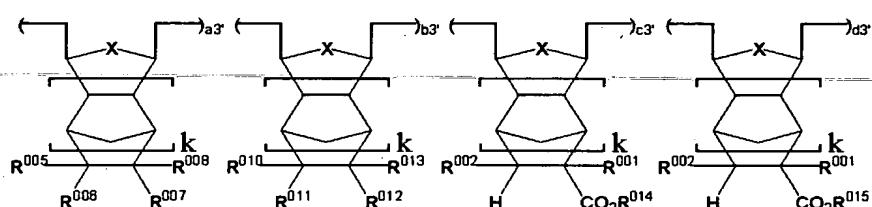
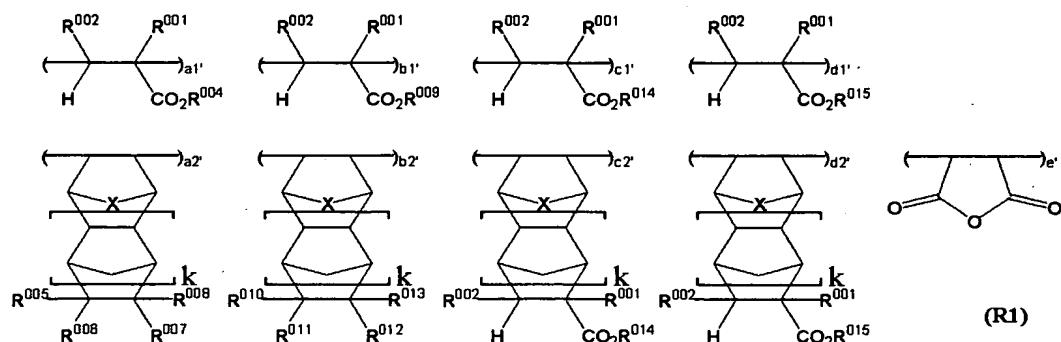
本発明のレジスト材料には、上記一般式(1)で示される高分子化合物とは別
の高分子化合物を添加することができる。

【0075】

該高分子化合物の具体的な例としては下記式(R1)及び/又は下記式(R2)
で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000
、好ましくは5,000~100,000のものを挙げることができるが、これら
に限定されるものではない。

【0076】

【化20】



(R2)

(式中、 R^{001} は水素原子、メチル基又は $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{R}^{003}$ を示す。 R^{002} は水素原子、メチル基又は $\text{CO}_2\text{R}^{003}$ を示す。 R^{003} は炭素数 1 ~ 15 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 R^{004} は水素原子又は炭素数 1 ~ 15 のカルボキシ基又は水酸基を含有する 1 倍の炭化水素基を示す。 $\text{R}^{005} \sim \text{R}^{008}$ の少なくとも 1 個は炭素数 1 ~ 15 のカルボキシ基又は水酸基を含有する 1 倍の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に水素原子又は炭素数 1 ~ 15 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 $\text{R}^{005} \sim \text{R}^{008}$ は互いに環を形成してもよく、その場合には $\text{R}^{005} \sim \text{R}^{008}$ の少なくとも 1 個は炭素数 1 ~ 15 のカルボキシ基又は水酸基を含有する 2 倍の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に单結合又は炭素数 1 ~ 15 の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示す。 R^{009} は炭素数 3 ~ 15 の $-\text{CO}_2-$ 部分構造を含有する 1 倍の炭化水素基を示す。 $\text{R}^{010} \sim \text{R}^{013}$ の少なくとも 1 個は炭素数 2

～15の-CO₂ー部分構造を含有する1価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に水素原子又は炭素数1～15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R⁰¹⁰～R⁰¹³は互いに環を形成してもよく、その場合にはR⁰¹⁰～R⁰¹³の少なくとも1個は炭素数1～15の-CO₂ー部分構造を含有する2価の炭化水素基を示し、残りはそれぞれ独立に単結合又は炭素数1～15の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基を示す。R⁰¹⁴は炭素数7～15の多環式炭化水素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基を示す。R⁰¹⁵は酸不安定基を示す。R⁰¹⁶は水素原子又はメチル基を示す。R⁰¹⁷は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。XはCH₂又は酸素原子を示す。k'は0又は1である。a_{1'}、a_{2'}、a_{3'}、b_{1'}、b_{2'}、b_{3'}、c_{1'}、c_{2'}、c_{3'}、d_{1'}、d_{2'}、d_{3'}、e'は0以上1未満の数であり、a_{1'}+a_{2'}+a_{3'}+b_{1'}+b_{2'}+b_{3'}+c_{1'}+c_{2'}+c_{3'}+d_{1'}+d_{2'}+d_{3'}+e'=1を満足する。f'、g'、h'、i'、j'は0以上1未満の数であり、f'+g'+h'+i'+j'=1を満足する。)

なお、それぞれの基の具体例については、先の説明と同様である。

【0077】

上記一般式(1)で示される高分子化合物と別の高分子化合物との配合比率は、100:0～10:90、特に100:0～20:80の重量比の範囲内にあることが好ましい。上記一般式(1)で示される高分子化合物の配合比がこれより少ないと、レジスト材料として好ましい性能が得られないことがある。上記の配合比率を適宜変えることにより、レジスト材料の性能を調整することができる。

【0078】

なお、上記高分子化合物は1種に限らず2種以上を添加することができる。複数種の高分子化合物を用いることにより、レジスト材料の性能を調整することができる。

【0079】

本発明のレジスト材料には、更に溶解制御剤を添加することができる。溶解制

御剤としては、平均分子量が100~1,000、好ましくは150~800で、かつ分子内にフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として平均0~100モル%の割合で置換した化合物又は分子内にカルボキシ基を有する化合物の該カルボキシ基の水素原子を酸不安定基により全体として平均50~100モル%の割合で置換した化合物を配合する。

【0080】

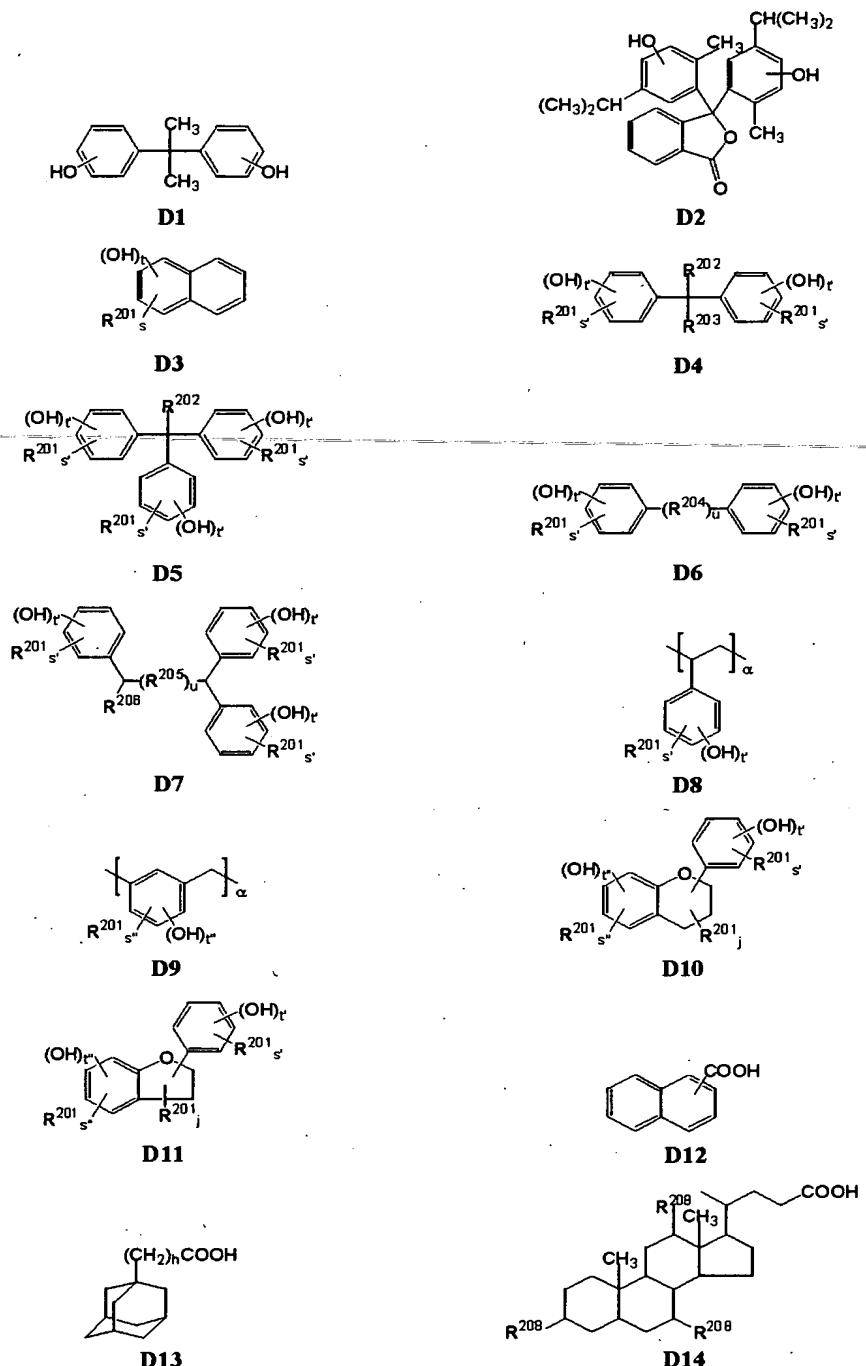
なお、フェノール性水酸基の水素原子の酸不安定基による置換率は、平均でフェノール性水酸基全体の0モル%以上、好ましくは30モル%以上であり、その上限は100モル%、より好ましくは80モル%である。カルボキシ基の水素原子の酸不安定基による置換率は、平均でカルボキシ基全体の50モル%以上、好ましくは70モル%以上であり、その上限は100モル%である。

【0081】

この場合、かかるフェノール性水酸基を2つ以上有する化合物又はカルボキシ基を有する化合物としては、下記式(D1)~(D14)で示されるものが好ましい。

【0082】

【化21】



(但し、式中 R²⁰¹、R²⁰² はそれぞれ水素原子、又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基を示す。R²⁰³ は水素原子、又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、或いは - (R²⁰⁷)_h COOH を示す。R²⁰⁴ は - (CH₂)_i - (i = 2～10)、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄

原子を示す。R²⁰⁵は炭素数1～10のアルキレン基、炭素数6～10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R²⁰⁶は水素原子、炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、又はそれぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基を示す。R²⁰⁷は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R²⁰⁸は水素原子又は水酸基を示す。jは0～5の整数である。u、hは0又は1である。s、t、s'、t'、s''、t''はそれぞれs+t=8、s'+t'=5、s''+t''=4を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも1つの水酸基を有するような数である。αは式(D8)、(D9)の化合物の分子量を100～1,000とする数である。)

【0083】

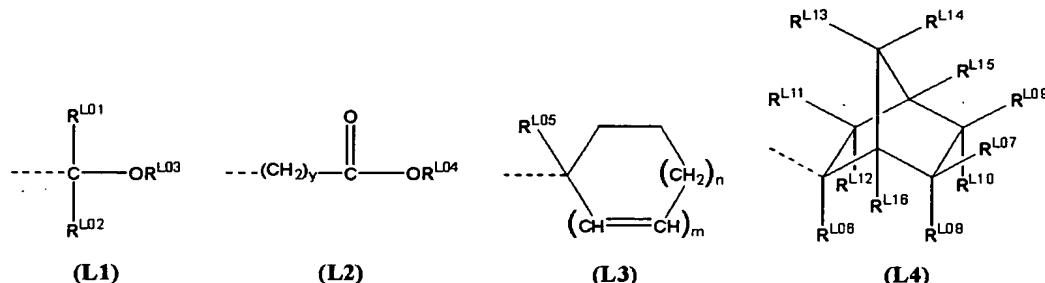
上記式中R²⁰¹、R²⁰²としては、例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、R²⁰³としては、例えばR²⁰¹、R²⁰²と同様なもの、或いは-COOH、-CH₂COOH、R²⁰⁴としては、例えばエチレン基、フェニレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子、硫黄原子等、R²⁰⁵としては、例えばメチレン基、或いはR²⁰⁴と同様なもの、R²⁰⁶としては例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0084】

溶解制御剤の酸不安定基としては、種々用いることができるが、具体的には下記一般式(L1)～(L4)で示される基、炭素数4～20の三級アルキル基、各アルキル基の炭素数がそれぞれ1～6のトリアルキルシリル基、炭素数4～20のオキソアルキル基等を挙げることができる。

【0085】

【化22】



(式中、 R^{L01} 、 R^{L02} は水素原子又は炭素数1～18の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。 R^{L03} は炭素数1～18の酸素原子等のヘテロ原子を有してもよい1価の炭化水素基を示す。 R^{L01} と R^{L02} 、 R^{L01} と R^{L03} 、 R^{L02} と R^{L03} とは環を形成してもよく、環を形成する場合には R^{L01} 、 R^{L02} 、 R^{L03} はそれぞれ炭素数1～18の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 R^{L04} は炭素数4～20の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1～6のトリアルキルシリル基、炭素数4～20のオキソアルキル基又は上記一般式(L1)で示される基を示す。 R^{L05} は炭素数1～8のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基又は炭素数6～20の置換されていてもよいアリール基を示す。 R^{L06} は炭素数1～8のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基又は炭素数6～20の置換されていてもよいアリール基を示す。 $R^{L07} \sim R^{L16}$ はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい1価の炭化水素基を示す。 $R^{L07} \sim R^{L16}$ は互いに環を形成していてもよく、その場合には炭素数1～15のヘテロ原子を含んでもよい2価の炭化水素基を示す。また、 $R^{L07} \sim R^{L16}$ は隣接する炭素に結合するもの同士で何も介さずに結合し、二重結合を形成してもよい。 y は0～6の整数である。 m は0又は1、 n は0、1、2、3のいずれかであり、 $2m+n=2$ 又は3を満足する数である。)

なお、それぞれの基の具体例については、先の説明と同様である。

【0086】

上記溶解制御剤の配合量は、ベース樹脂100部に対し、0～50部、好ましくは0～40部、より好ましくは0～30部であり、単独又は2種以上を混合して使用できる。配合量が50部を超えるとパターンの膜減りが生じ、解像度が低

下する場合がある。

【0087】

なお、上記のような溶解制御剤は、フェノール性水酸基又はカルボキシ基を有する化合物に対し、有機化学的処方を用いて酸不安定基を導入することにより合成される。

【0088】

更に、本発明のレジスト材料には、塩基性化合物を配合することができる。

塩基性化合物としては、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適している。塩基性化合物の配合により、レジスト膜中の酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やパターンプロファイル等を向上することができる。

【0089】

このような塩基性化合物としては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0090】

具体的には、第一級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチルアミン、sec-ブチルアミン、tert-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミルアミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペンタミン等が例示され、第二級の脂肪族アミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジ-n-ブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジ-sec-ブチルアミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシ

ルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N-ジメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレンジアミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペニタミン等が例示され、第三級の脂肪族アミン類として、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ-n-プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリ-n-ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリ-sec-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリセチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルメチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルテトラエチレンペニタミン等が例示される。

【0091】

また、混成アミン類としては、例えばジメチルエチルアミン、メチルエチルブロピルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミン等が例示される。芳香族アミン類及び複素環アミン類の具体例としては、アニリン誘導体（例えばアニリン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プロピルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニトロアニリン、2, 4-ジニトロアニリン、2, 6-ジニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等）、ジフェニル（p-トリル）アミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタレン、ピロール誘導体（例えばピロール、2H-ピロール、1-メチルピロール、2, 4-ジメチルピロール、2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等）、オキサゾール誘導体（例えばオキサゾール、イソオキサゾール等）、チアゾール誘導体（例えばチアゾール、イソチアゾール等）、イミダゾール誘導体（例えばイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール等）、ピラゾール誘導体、フラザン誘導体、ピロリ

ン誘導体（例えばピロリン、2-メチル-1-ピロリン等）、ピロリジン誘導体（例えばピロリジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチルピロリドン等）、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導体、ピリジン誘導体（例えばピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピリジン、4-(1-ブチルペンチル)ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリドン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等）、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体（例えばキノリン、3-キノリンカルボニトリル等）、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、ブテリジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0092】

更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン酸、アミノ酸誘導体（例えばニコチン酸、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシアラニン）等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化合物として3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ピリジニウム等が例示され、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物としては、

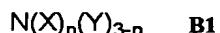
2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、2, 2'-イミノジエタノール、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]ピペラジン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3-ピペリジノ-1, 2-プロパンジオール、3-ピロリジノ-1, 2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイミド、N-(2-ヒドロキシエチル)イソニコチニアミド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。

【0093】

更に、下記一般式(B1)で示される塩基性化合物から選ばれる1種又は2種以上を配合することもできる。

【0094】

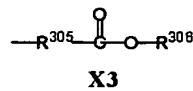
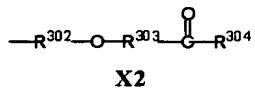
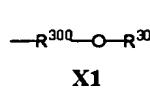
【化23】



(式中、n=1、2又は3である。Yは各々独立に水素原子又は直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1~20のアルキル基を示し、ヒドロキシ基又はエーテルを含んでもよい。Xは各々独立に下記一般式(X1)~(X3)で表される基を示し、2個又は3個のXが結合して環を形成してもよい。)

【0095】

【化24】



(式中 R^{300} 、 R^{302} 、 R^{305} は炭素数 1 ~ 4 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 R^{301} 、 R^{304} は水素原子、又は炭素数 1 ~ 20 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を示し、ヒドロキシ基、エーテル、エステル又はラクトン環を 1 個又は複数個含んでいてもよい。 R^{303} は単結合又は炭素数 1 ~ 4 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。)

【0096】

上記一般式 (B1) で表される化合物として具体的には、トリス (2-メトキシメトキシエチル) アミン、トリス {2- (2-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2- (2-メトキシエトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2- (1-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2- (1-エトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2- (1-エトキシプロポキシ) エチル} アミン、トリス [2- {2- (2-ヒドロキシエトキシ) エトキシ} エチル] アミン、4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサ-1, 10-ジアザビシクロ [8. 8. 8] ヘキサコサン、4, 7, 13, 18-テトラオキサ-1, 10-ジアザビシクロ [8. 5. 5] エイコサン、1, 4, 10, 13-テトラオキサ-7, 16-ジアザビシクロオクタデカン、1-アザ-12-クラウン-4、1-アザ-15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6、トリス (2-フオルミルオキシエチル) アミン、トリス (2-ホルミルオキシエチル) アミン、トリス (2-アセトキシエチル) アミン、トリス (2-プロピオニルオキシエチル) アミン、トリス (2-イソブチリルオキシエチル) アミン、トリス (2-バレリルオキシエチル) アミン、トリス (2-ピバロイルオキシキシエチル) アミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (アセトキシアセトキシ) エチルアミン、トリス (2-メトキシカルボニルオキシエチル) アミン、トリス (2-tert-ブトキシカルボニルオキシエチル) アミン、トリス [2- (2-オキソプロポキシ) エチル] アミン、トリス [2- (メトキシカルボニルメチル) オキシエチル] アミン、トリ

ス [2-(tert-ブトキシカルボニルメチルオキシ)エチル]アミン、トリス[2-(シクロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ)エチル]アミン、トリス(2-メトキシカルボニルエチル)アミン、トリス(2-エトキシカルボニルエチル)アミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(メトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(メトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(エトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(エトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-ヒドロキシエトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(2-メトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[メトキシカルボニル]エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[メトキシカルボニル]エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-オキソプロポキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(2-オキソプロポキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(テトラヒドロフルフリルオキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-(テトラヒドロフルフリルオキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)オキシカルボニル]エチルアミン、N,N-ビス(2-アセトキシエチル)2-[2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル]オキシカルボニル]エチルアミン、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)2-(4-ヒドロキシブトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)2-(4-ホルミルオキシブトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-ホルミルオキシエチル)2-(2-ホルミルオキシエトキシカルボニル)エチルアミン、N,N-ビス(2-メトキシエチル)2-(メトキシカルボニル)エチルアミン、N-(2-ヒドロキシエチル)ビス[2-

(メトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(2-アセトキシエチル)ビス[2-(メトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(2-ヒドロキシエチル)ビス[2-(エトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(2-アセトキシエチル)ビス[2-(エトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(3-ヒドロキシ-1-プロピル)ビス[2-(メトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(3-アセトキシ-1-プロピル)ビス[2-(メトキシカルボニル)エチル]アミン、N-(2-メトキシエチル)ビス[2-(メトキシカルボニル)エチル]アミン、N-ブチルビス[2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチル]アミン、N-メチルビス(2-アセトキシエチル)アミン、N-エチルビス(2-アセトキシエチル)アミン、N-メチルビス(2-ピバロイルオキシキシエチル)アミン、N-エチルビス[2-(メトキシカルボニルオキシ)エチル]アミン、N-エチルビス[2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)エチル]アミン、トリス(メトキシカルボニルメチル)アミン、トリス(エトキシカルボニルメチル)アミン、N-ブチルビス(メトキシカルボニルメチル)アミン、N-ヘキシリビス(メトキシカルボニルメチル)アミン、 β -(ジエチルアミノ)- δ -バレロラクトン等が例示できる。

【0097】

上記塩基性化合物の配合量は、酸発生剤1部に対して0.001~10部、好ましくは0.01~1部である。配合量が0.001部未満であると添加剤としての効果が十分に得られない場合があり、10部を超えると解像度や感度が低下する場合がある。

【0098】

更に、本発明のレジスト材料には、分子内に $\equiv C-COOH$ で示される基を有する化合物を配合することができる。

【0099】

分子内に $\equiv C-COOH$ で示される基を有する化合物としては、例えば下記I群及びII群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を使用することができるが、これらに限定されるものではない。本成分の配合により、レジストのPED安

定性が向上し、窒化膜基板上でのエッジラフネスが改善されるのである。

[I群]

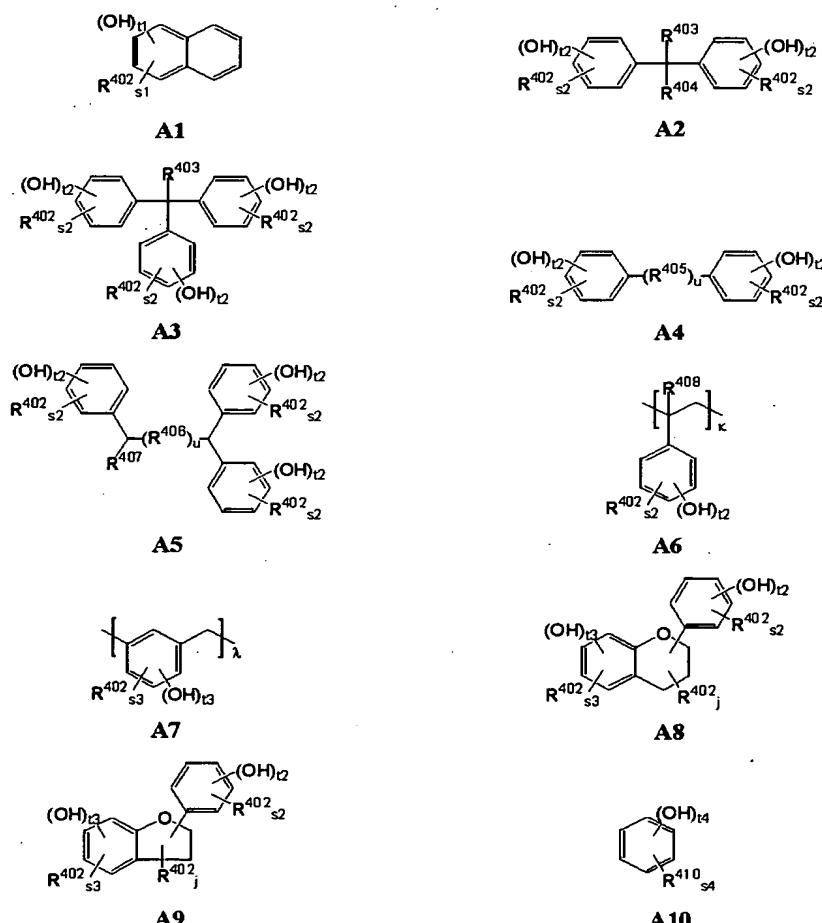
下記一般式 (A1) ~ (A10) で示される化合物のフェノール性水酸基の水素原子の一部又は全部を $-R^{401}-COOH$ (R^{401} は炭素数 1 ~ 10 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基) により置換してなり、かつ分子中のフェノール性水酸基 (C) と $\equiv C-COOH$ で示される基 (D) とのモル比率が $C/(C+D) = 0.1 \sim 1.0$ である化合物。

[II群]

下記一般式 (A1-1) ~ (A1-5) で示される化合物。

【0100】

【化25】

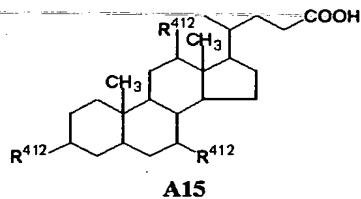
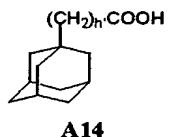
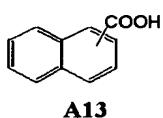
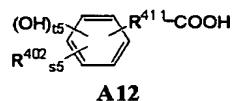
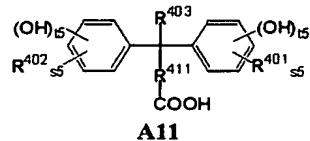


(但し、式中 R^{408} は水素原子又はメチル基を示す。 R^{402} 、 R^{403} はそれぞれ水素原子又は炭素数 1 ~ 8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニ

ル基を示す。R⁴⁰⁴は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、或いは-(R⁴⁰⁹)_h-COOR'基(R'は水素原子又は-R⁴⁰⁹-COOH)を示す。R⁴⁰⁵は-(CH₂)_i-(i=2～10)、炭素数6～10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R⁴⁰⁶は炭素数1～10のアルキレン基、炭素数6～10のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子を示す。R⁴⁰⁷は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基を示す。R⁴⁰⁹は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R⁴¹⁰は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基又は-R⁴¹¹-COOH基を示す。R⁴¹¹は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。jは0～5の整数である。u、hは0又は1である。s1、t1、s2、t2、s3、t3、s4、t4はそれぞれs1+t1=8、s2+t2=5、s3+t3=4、s4+t4=6を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも1つの水酸基を有するような数である。κは式(A6)の化合物を重量平均分子量1,000～5,000とする数である。λは式(A7)の化合物を重量平均分子量1,000～10,000とする数である。)

【0101】

【化26】



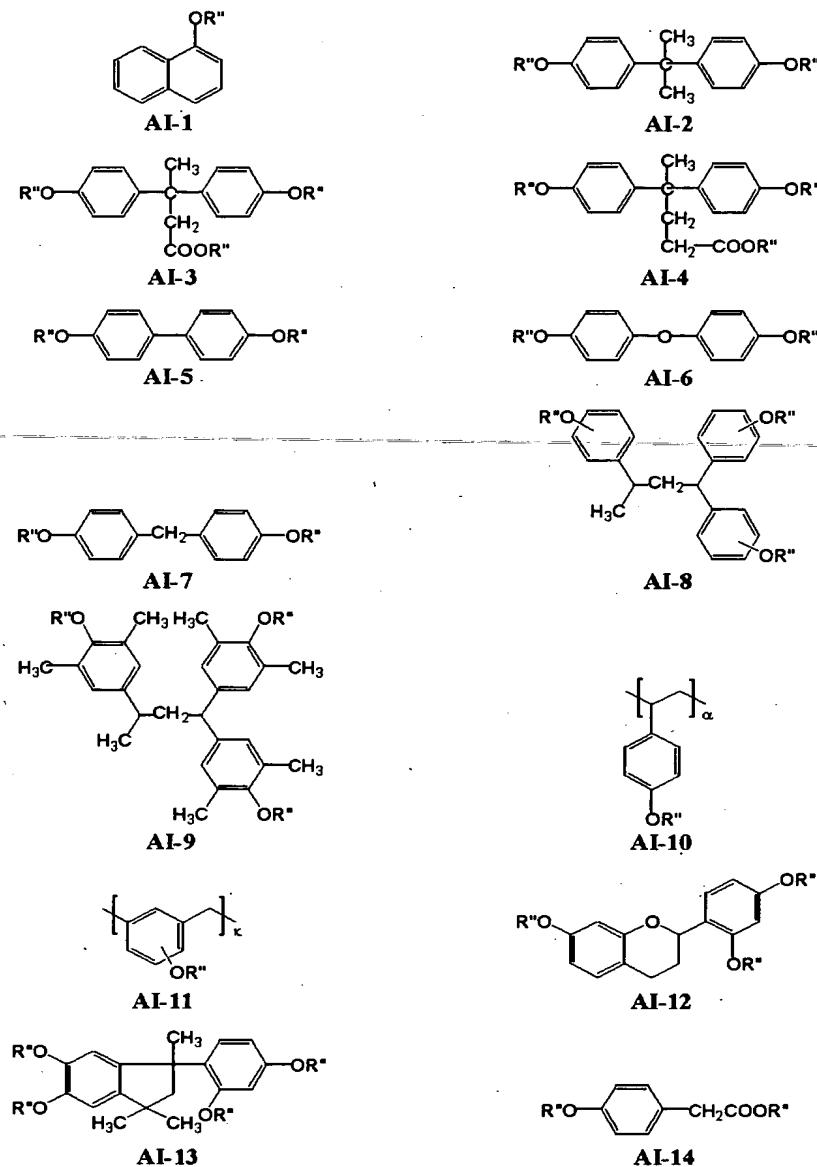
(R⁴⁰²、R⁴⁰³、R⁴¹¹は上記と同様の意味を示す。R⁴¹²は水素原子又は水酸基を示す。s₅、t₅は、s₅≥0、t₅≥0で、s₅+t₅=5を満足する数である。h'は0又は1である。)

【0102】

本成分として、具体的には下記一般式A I - 1～14及びA II - 1～10で示される化合物を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

【0103】

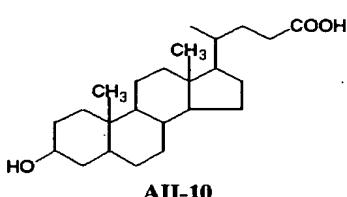
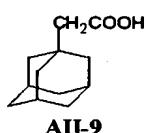
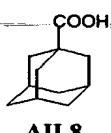
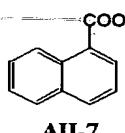
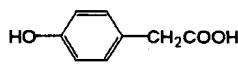
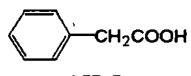
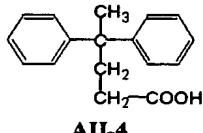
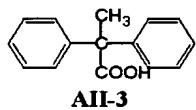
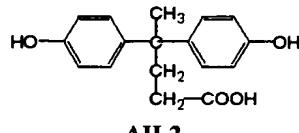
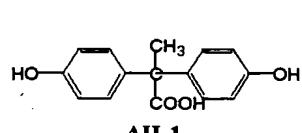
【化27】



(R'')は水素原子又はCH₂COOH基を示し、各化合物においてR'」の10～100モル%はCH₂COOH基である。α、κは上記と同様の意味を示す。)

【0104】

【化28】



【0105】

なお、上記分子内に $\equiv C-COOH$ で示される基を有する化合物は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0106】

上記分子内に $\equiv C-COOH$ で示される基を有する化合物の添加量は、ベース樹脂100部に対して0~5部、好ましくは0.1~5部、より好ましくは0.1~3部、更に好ましくは0.1~2部である。5部より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0107】

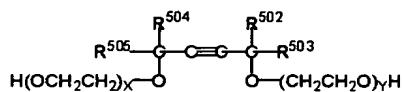
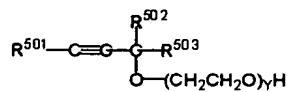
更に、本発明のレジスト材料には、添加剤としてアセチレンアルコール誘導体を配合することができ、これにより保存安定性を向上させることができる。

【0108】

アセチレンアルコール誘導体としては、下記一般式(S1)、(S2)で示されるものを好適に使用することができる。

【0109】

【化29】



(式中、 R^{501} 、 R^{502} 、 R^{503} 、 R^{504} 、 R^{505} はそれぞれ水素原子、又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、 X 、 Y は0又は正数を示し、下記値を満足する。 $0 \leq X \leq 30$ 、 $0 \leq Y \leq 30$ 、 $0 \leq X + Y \leq 40$ である。)

【0110】

アセチレンアルコール誘導体として好ましくは、サーフィノール6.1、サーフィノール8.2、サーフィノール10.4、サーフィノール10.4E、サーフィノール10.4H、サーフィノール10.4A、サーフィノールTG、サーフィノールPC、サーフィノール44.0、サーフィノール46.5、サーフィノール48.5(Air Products and Chemicals Inc. 製)、サーフィノールE1004(日信化学工業(株) 製)等が挙げられる。

【0111】

上記アセチレンアルコール誘導体の添加量は、レジスト材料100重量%中0.01～2重量%、より好ましくは0.02～1重量%である。0.01重量%より少ないと塗布性及び保存安定性の改善効果が十分に得られない場合があり、2重量%より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0112】

本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0113】

ここで、界面活性剤としては非イオン性のものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチレンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキルEIO付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「FC-431」(いずれも住友スリーエム(株) 製)、サーフロン「S-141

」、「S-145」（いずれも旭硝子（株）製）、ユニダイン「DS-401」、「DS-403」、「DS-451」（いずれもダイキン工業（株）製）、メガファック「F-8151」（大日本インキ工業（株）製）、「X-70-092」、「X-70-093」（いずれも信越化学工業（株）製）等を挙げることができる。好ましくは、フロラード「FC-430」（住友スリーエム（株）製）、「X-70-093」（信越化学工業（株）製）が挙げられる。

【0114】

本発明のレジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して行うことができ、例えばシリコンウエハー等の基板上にスピンドルコーティング等の手法で膜厚が0.2~2.0 μm となるように塗布し、これをホットプレート上で60~150°C、1~10分間、好ましくは80~130°C、1~5分間プリベークする。次いで目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エネルギー線もしくは電子線を露光量1~200 mJ/cm²程度、好ましくは5~100 mJ/cm²程度となるように照射した後、ホットプレート上で60~150°C、1~5分間、好ましくは80~130°C、1~3分間ポストエクスポージャベーク（PEB）する。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド（TMAH）等のアルカリ水溶液の現像液を用い、0.1~3分間、好ましくは0.5~2分間、浸漬（dip）法、パドル（paddle）法、スプレー（spray）法等の常法により現像することにより基板上に目的のパターンが形成される。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも248~193 nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、X線及び電子線による微細パターンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることができない場合がある。

【0115】

【発明の効果】

本発明の高分子化合物をベース樹脂としたレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、感度、解像性、エッチング耐性に優れているため、電子線や遠紫外線による微細加工に有用である。特にArFエキシマレーザー、KrFエキシマレー

ザーの露光波長での吸収が小さいため、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成することができるという特徴を有する。

【0116】

【実施例】

以下、合成例及び実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

【合成例】

本発明の高分子化合物を、以下に示す処方で合成した。

【合成例1】 Polymer 1 の合成

20.80 g (160 mmol) のアクリレインジエチルアセタール、14.88 g (60 mmol) のメタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル及び3.57 g の1,4-ジオキサンを混合した。この反応混合物を60°Cまで加熱し、0.74 g (3 mmol) の2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレニトリル)を加え、60°Cを保ちながら15時間攪拌した。室温まで冷却した後、50 ml のアセトンに溶解し、1,000 ml のイソプロピルアルコールに激しく攪拌しながら滴下した。生じた固形物を濾過して取り、40°Cで15時間真空乾燥したところ、10.08 g の白色粉末固体を得た。¹H-NMRで分析したところ、下記式 Polymer 1 で示される高分子化合物であることが確認された。なお、M_wは、ポリスチレン換算でのGPCを用いて測定した重量平均分子量を表す。

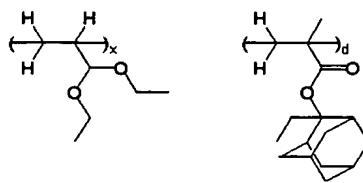
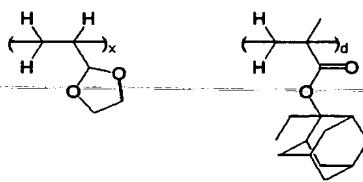
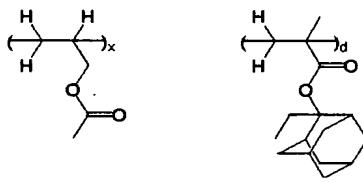
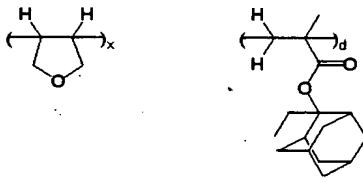
【0117】

【合成例2~8】 Polymer 2~8 の合成

上記と同様にして、又は公知の処方で、Polymer 2~8 を合成した。

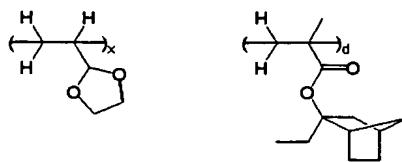
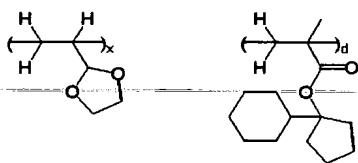
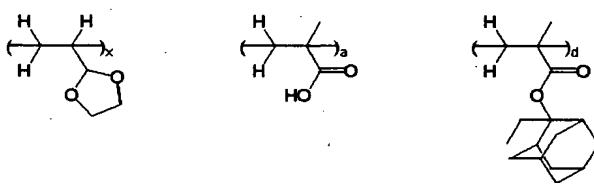
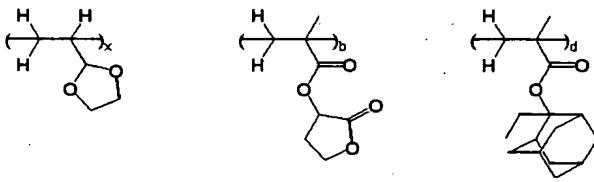
【0118】

【化30】

(Polymer 1)
($x=0.40$, $d=0.60$, $Mw=6,800$)(Polymer 2)
($x=0.40$, $d=0.60$, $Mw=7,300$)(Polymer 3)
($x=0.40$, $d=0.60$, $Mw=8,000$)(Polymer 4)
($x=0.40$, $d=0.60$, $Mw=6,100$)

【0119】

【化31】

(Polymer 5)
(x=0.40, d=0.60, Mw=7,400)(Polymer 6)
(x=0.40, d=0.60, Mw=7,100)(Polymer 7)
(x=0.40, a=0.10, d=0.50, Mw=8,600)(Polymer 8)
(x=0.30, b=0.20, d=0.50, Mw=8,200)

【0120】

[実施例]

本発明のレジスト材料について、ArFエキシマレーザー露光における解像性の評価を行った。

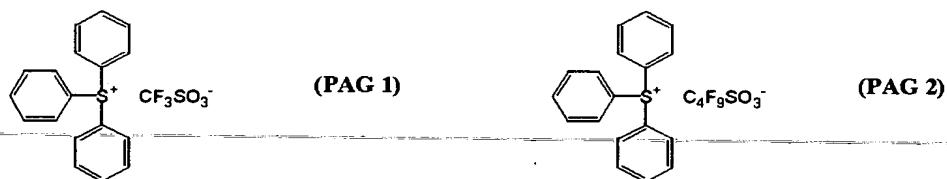
[実施例II-1~17] レジストの解像性の評価

上記式で示されるポリマー (Polymer 1~8) をベース樹脂とし、下記式で示される酸発生剤 (PAG 1、2)、下記式で示される溶解制御剤 (DRR

1～4）、塩基性化合物、下記式で示される分子内に $\equiv\text{C}-\text{C}\text{OOH}$ で示される基を有する化合物（ACC1、2）及び溶剤を、表1に示す組成で混合した。次にそれらをテフロン製フィルター（孔径0.2 μm）で濾過し、レジスト材料とした。

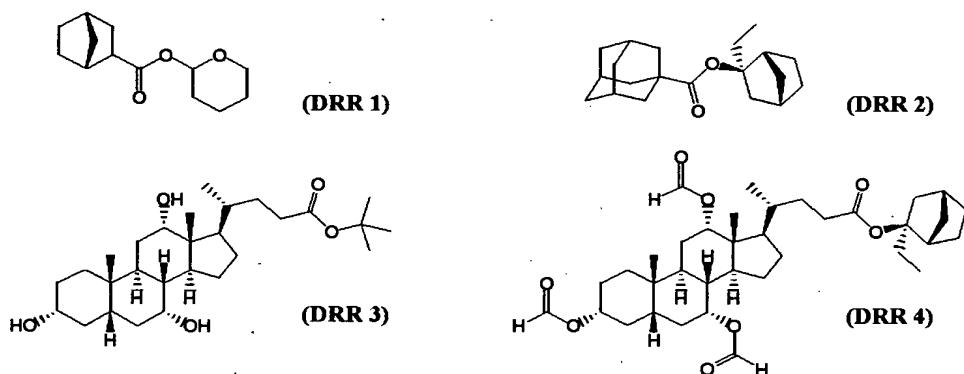
[0 1 2 1]

【化.3 2】



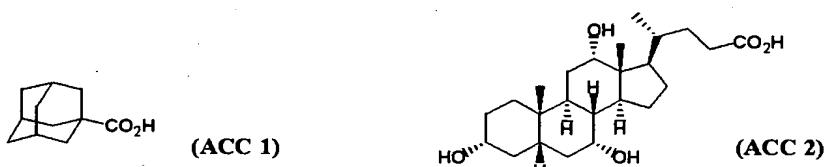
[0 1 2 2]

【化 3 3】



[0 1 2 3]

【化 3 4】



[0 1 2 4]

レジスト液を反射防止膜（日産化学社製ARC25、77 nm）を塗布したシリコンウエハー上へ回転塗布し、130°C、90秒間の熱処理を施して、厚さ375 nmのレジスト膜を形成した。これをArFエキシマレーザーステッパー（ニコン社製、NA = 0.55）を用いて露光し、110°C、90秒間の熱処理を

施した後、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて60秒間パドル現像を行い、1:1のラインアンドスペースパターンを形成した。現像済ウエハーを割断したものを断面SEM(走査型電子顕微鏡)で観察し、0.20 μm のラインアンドスペースを1:1で解像する露光量(最適露光量= E_{op} 、 mJ/cm^2)における分離しているラインアンドスペースの最小線幅(μm)を評価レジストの解像度とした。また、その際のパターンの形状を矩形、頭丸、Tトップ、順テーパー、逆テーパーのいずれかに分類することとした。

【0125】

各レジストの組成及び評価結果を表1に示す。なお、表1において、溶剤及び塩基性化合物は下記の通りである。また、溶剤は全てFC-430(住友シリーエム(株)製)を0.01重量%含むものを用いた。

PGMEA: プロピレングリコールメチルエーテルアセテート

TEA: トリエタノールアミン

TMMEA: トリスメトキシメトキシエチルアミン

TMEMEA: トリスメトキシエトキシメトキシエチルアミン

【0126】

【表1】

実施例	樹脂 (重量部)	酸発生剤 (重量部)	溶解制御剤 (重量部)	塩基性化合物 (重量部)	溶剤 (重量部)	最適露光量 (mJ/cm ²)	解像度 (μm)	形状
1	Polymer 1 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	34.0	0.16	矩形
2	Polymer 2 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
3	Polymer 3 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
4	Polymer 4 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	38.0	0.16	矩形
5	Polymer 5 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	32.0	0.16	矩形
6	Polymer 6 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	30.0	0.16	矩形
7	Polymer 7 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	34.0	0.16	矩形
8	Polymer 8 (80)	PAG 1 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
9	Polymer 1 (80)	PAG 2 (1)	—	TEA (0.125)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
10	Polymer 1 (80)	PAG 2 (1)	—	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	36.0	0.15	矩形
11	Polymer 1 (80)	PAG 2 (1)	—	TMMEA (0.347)	PGMEA (480)	40.0	0.15	矩形
12	Polymer 2 (70)	PAG 2 (1)	DRR 1 (10)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	34.0	0.17	若干頭丸
13	Polymer 2 (70)	PAG 2 (1)	DRR 2 (10)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
14	Polymer 2 (70)	PAG 2 (1)	DRR 3 (10)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	40.0	0.16	矩形
15	Polymer 2 (70)	PAG 2 (1)	DRR 4 (10)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形
16	Polymer 3 (80)	PAG 2 (1)	ACC 1 (4)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	32.0	0.17	若干頭丸
17	Polymer 3 (80)	PAG 2 (1)	ACC 2 (4)	TMMEA (0.236)	PGMEA (480)	36.0	0.16	矩形

【0127】

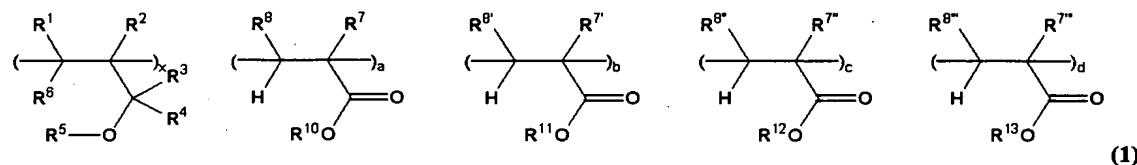
表1の結果より、本発明のレジスト材料が、ArFエキシマレーザー露光において、高感度かつ高解像性であることが確認された。

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

【化1】



(式中、R¹、R²はH又はCH₃、R³、R⁴はH、OH又は1価の炭化水素基、R⁵はH又は1価の炭化水素基、R⁶はH又はCH₃、R⁷はH、CH₃又はCH₂CO₂R⁹、R^{7'}はH、CH₃又はCH₂CO₂R^{9'}、R^{7''}はH、CH₃又はCH₂CO₂R^{9''}、R^{7'''}はH、CH₃又はCH₂CO₂R^{9'''}、R⁸はH、CH₃又はCO₂R⁹、R^{8'}はH、CH₃又はCO₂R^{9'}、R^{8''}はH、CH₃又はCO₂R^{9''}、R^{8'''}はH、CH₃又はCO₂R^{9'''}、R⁹、R^{9'}、R^{9''}、R^{9'''}はアルキル基、R¹⁰はH又はカルボキシ基又はOHを含有する1価の炭化水素基、R¹¹はエーテル、エステル又はカルボン酸無水物構造を含有する1価の炭化水素基、R¹²は多環式炭化水素基又は多環式炭化水素基を含有するアルキル基、R¹³は酸不安定基、x、a、b、c、dは各繰り返し単位のモル組成比を示し、xは0を超える数、a、b、cは0以上の数、dは0を超える数で、x+a+b+c+d=1である。)

【効果】 本発明の高分子化合物をベース樹脂としたレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、感度、解像性、エッチング耐性に優れているため、電子線や遠紫外線による微細加工に有用である。特にArFエキシマレーザー、KrFエキシマレーザーの露光波長での吸収が小さいため、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成することができるという特徴を有する。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号 [000002060]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区大手町二丁目6番1号

氏 名 信越化学工業株式会社